

1 はじめに

材料中の局所ナノ構造(界面,表面,転位等) は、材料特性と密接に関連している。高機能、 高性能な材料を創成するためには、局所ナノ構 造を原子・電子レベルから解明し、的確に制御 する必要がある。近年, 収差補正機を搭載した 走查型透過電子顕微鏡 (Scanning Transmission Electron Microscope: STEM) において 0.5 Å以 下の分解能が達成され¹⁻³⁾、局所ナノ構造の原 子レベルの直接観察が日常的に行われるように なっている。STEM においては、電子プローブ が照射された領域から出てくる電子信号をどの ように検出し、像を形成するのかという検出側 が重要となる。実際,同一の電子プローブを用 いても検出器の形状や配置(ジオメトリ)を変 化させることにより、全く異なるコントラスト を呈する像を形成することが可能である。言い 換えれば、像に反映される構造情報は検出器の ジオメトリと密接に関連している。本稿では. 超高分解能を実現した STEM において、検出 器ジオメトリの詳細な検討により、様々な原子 レベルの構造情報抽出が可能であることを報告 する。また、このような観察を可能にする多分 割型 STEM 検出器の開発についても紹介する。

2 STEM 法の概要と種々の観察法

図1にSTEM法の模式図を示す。STEMは 細く絞った電子線を試料上で走査し,試料各点 から発生した透過散乱電子を試料下部の環状検



図1 STEM 法の模式図 HAADF 検出器と ABF 検出器を配置を示す

出器により検出し、その強度をモニター上に二 次元像として表示する手法である。STEMの像 コントラストは、透過散乱電子を検出する検出 器の形状、検出角度、配置等により大きく影響 を受けることが知られている⁴⁻¹⁰⁾。現在スタン ダードな検出法として、円状の検出器で透過電 子を検出し結像する明視野(Bright-Field:BF) 法、低角散乱された電子のみを選択的に検出す る低角度環状暗視野(Low-Angle Annual Dark-Field:LAADF)法、高角散乱された電子のみ を選択的に検出する高角度環状暗視野(High-Angle Annual Dark-Field:HAADF)法などが広 く利用されている。これらの検出法は異なる像 コントラスト、すなわち異なる構造情報を抽出 できるため、材料情報を多角的に捉える上では 検出ジオメトリの異なる複数の STEM 像を同 時に取得することが重要であると考えられる。 通常このような STEM 像の同時取り込みは, 独立した環状検出器を複数本体に導入すること で行われており,現行の商用機も複数の環状検 出器を導入するモデルが一般的となっている。

3 環状明視野 (Annual Bright-Field: ABF) STEM 法による軽元素原子観察

これまで電子顕微鏡分野では,材料中の軽元 素原子を直接観察するための様々な方法が検討 されてきた。しかし,軽元素原子は電子散乱能 が極めて小さく,原子レベルの観察は極めて困 難であるとされてきた。特に,重元素と軽元素 が混在する化合物中の軽元素原子の直接観察は 非常に困難であった。

このような問題を解決する手法として、環状 明視野(ABF)法が開発された¹¹⁻¹³⁾。図1に示 すように、ABF法はHAADF法に比べて非常 に小さな環状検出器を明視野領域に導入し、像 を形成する手法である。一般的な原子分解能観 察手法である HAADF 法では,高角散乱された 電子のみを選択的に検出するよう設定する。つ まり HAADF 法では、電子散乱能の小さい軽元 素原子コラム(奥行方向への原子の並んだ原子 列)からの散乱電子信号は極めて弱くなってし まうため, 軽元素観察には不向きな手法である と言える。一方, ABF 法では検出器の外角を プローブ収束角と同程度に小さく設定し、検出 器内角をその半分程度にすることで,明視野領 域の透過散乱電子を選択的に検出するよう設定 する。この方法により観察した酸化物結晶の実 験像を図2(a), (c) に示す。比較のため同時 観察した HAADF 像も図2(b).(d) に示す。 図中に示した結晶構造モデルから明らかなよう に、HAADF像においては結晶中の酸素原子コ ラムの信号はほかの重原子コラムのコントラス トに比べて極めて弱い。一方 ABF 像では、 HAADF 像とは反対に原子コラム位置が暗コン トラストで結像されるものの、酸素原子コラム



図 2 SrTiO₃[110] と TiO₂[001] の (a) (c) ABF 及び (b) (d) HAADF STEM 像

位置にも明瞭なコントラストが生成しており, コントラストから酸素原子コラム位置を直接同 定することが可能である。この手法により,こ れまで観察が極めて困難であった水素原子コラ ムの直接観察が可能となっている^{14,15)}。

4 多分割型検出器の開発と電磁場構造観察

前述のように、原子分解能 STEM の像コン トラストは散乱電子角度範囲(=検出器範囲) に大きく依存するため、得られる材料情報は検 出器ジオメトリと密接に関連している。しか し,現行の手法は散乱電子を環状一括検出する ことを前提としており、検出器ジオメトリとし ては限定的な利用に留まっている。原子分解能 STEM において用いられる環状検出器には、通 常シンチレータ+光電子増倍管 (Photomaltiplier Tube: PMT)の構成が利用されている。こ れは、1 Å 以下に絞った電子プローブからの微 弱な散乱電子さえも高感度に検出しなければな らないためである。筆者らは図3(a)に模式的 に示すような検出面上を16分割した検出器を 作製し,各分割セグメントごとにファイバー束 をカップリングさせ、PMT で検出・増幅する 原子分解能対応多分割検出器を開発した¹⁶⁾。分 割形状としては、動径方向には円形状に、面内 回転方向には90°セクター型の分割形状を採用



図3 (a) 分割型検出器の模式図,(b) この検出器で同時取得した 16 枚の原子分解能 STEM 像

した。図3(b)にこの検出器を用いて同時検出 した16枚のSrTiO₃[001]原子分解能STEM像 を示す。

この検出器を用いて、対角に向き合う検出セ グメントの差分像を検討した17)。本手法は、微 分位相コントラスト法 (Differential phase contrast:DPC)と呼ばれている⁵⁾。これまでの理 論的な解析から、DPC のコントラストは試料 が十分薄い場合、近似的に試料ポテンシャルの 微分(=電磁場)に対応することが示されてお り4)、本手法を原子分解能観察に応用できれば 原子レベルの電磁場情報を直接取得できる可能 性がある。そこで原子分解能 DPC STEM の可 能性を実験的に検証するため,多分割検出器を 用いて SrTiO, を [001] 方向から観察し, 差分 像を形成した結果を図4に示す¹⁷⁾。図の上段左 図は検出器とSrTiO₃結晶の相対方位関係を示 し、上段右図は同時取得した HAADF 像を示 す。図の中段はそれぞれ(6-8),(5-7)の差分 像(DPC像)を示しており、下段はそれぞれ のDPC像の強度プロファイルを示している。 DPC 像強度プロファイルと HAADF 像強度プ ロファイルを比較すると、DPC 強度プロファ イルは原子カラム位置を基準として正負が反転 した反対称な強度プロファイルとなることが分 かった。差分方向の異なる(6-8) DPC 像及び



▲ 4 原子分辨能 DPC STEM 観祭の例 SrTiO₃ を [001] 方向から観察している

(5-7) DPC 像ともに同様のプロファイルが観察 されており、これが原子分解能 DPC STEM 像 の特徴であると考えられる。詳細な理論計算に



図 5 DPC STEM による半導体 pn 接合の観察例 同時取得した (a) ADF STEM 像及び (b) DPC STEM 像。DPC STEM 像においてのみ p 領域と n 領域の境 界に強いコントラストが観察できる

より,この反対称プロファイルは原子周囲の電 場分布を反映しており,原子の中心を挟んで電 場の方向が逆転することを可視化していること に対応することが分かった¹⁷⁾。本手法を強誘電 体の原子構造解析に応用することにより,単位 胞中の電気双極子形成を敏感に検出したり¹⁷⁾, 半導体 pn 接合の直接観察にも有力であると考 えられる(図5)¹⁸⁾。このように DPC STEM は, 電場を高精度に検出できる手法であり,誘電 体,蓄電池材料,太陽電池など,局所的な電場 やポテンシャル構造の理解が不可欠な分野への 応用が期待できる。

5 今後の展望

今回開発した多分割 STEM 検出器は,原子 分解能観察に対応可能であり,新しい STEM 法の開拓にも有益であると考えられる。最近で はピクセル型検出器で原子レベルに絞り込んだ 電子プローブからの収束電子回折図形を二次元 的に記録するシステムの検討も盛んになってお り^{19,20)},今後の展開に期待したい。本稿で紹介 したように,STEM 像が呈する材料情報は検出 器のジオメトリと密接に関連するため,検出ジ オメトリと材料情報の関係を詳細に検討してい くことが,更なる STEM 法の可能性を開くも のと期待する。

【謝辞】

本稿で紹介した研究は,東京大学の幾原雄一

博士,松元隆夫博士,モナッシュ大学のS.D. Findlay博士,日本電子(株)の河野祐二氏,沢 田英敬博士,古河電気工業(株)の佐々木宏和博 士らとの共同研究により遂行されました。本研 究は,JST さきがけ,JST 先端計測,文部科学 省科研費新学術領域研究「ナノ構造情報のフロ ンティア開拓」,基盤研究(B)26289234 などの 助成の下,遂行されました。本研究の一部は, 文部科学省のナノテクプラットフォーム事業の 支援を受けた東京大学先端ナノ計測ハブ拠点に おいて実施されました。ここに合わせて謝意を 表します。

参考文献

- 1) Sawada, H., et al., Microsc., 64, 213 (2015)
- Sawada, H., et al., J. Electron Microsc., 58, 357 (2009)
- Erni, R., Rossel, M.D., Kisielowski, C., and Dahmen, U., *Phys. Rev. Lett.*, **102**, 096101 (2009)
- 4) Rose, H., Ultramicroscopy, 2, 251 (1977)
- 5) Dekkers, N.H. and de Lang, H.D., *Optik*, **41**, 452 (1974)
- Daberkow, I., Herrmann, K.H., and Lenz, F., Ultramicroscopy, 50, 75 (1993)
- Chapman, J.N., McFadyen, I.R., and McVitie, S., *IEEE Trans. Mag.*, **26**, 1506 (1990)
- 8) Cowley, J.M., Ultramicroscopy, 49, 4 (1993)
- Pennycook, S.J. and Jesson, D.E., *Phys. Rev. Lett.*, 64, 938 (1990)
- 10) Perovic, D.D., Rossow, C.J., and Howie, A., *Ultramicroscopy*, **52**, 353 (1994)
- 11) Okunishi, E., *et al.*, *Microsc. Microanal.*, 15, Suppl. 2, 164 (2009)
- 12) Findlay, S.D., et al., Appl. Phys. Lett., 95, 191913 (2009)
- 13) Findlay, S.D., *et al.*, *Ultramicroscopy*, **110**, 903 (2010)
- 14) Findlay, S.D., et al., Appl. Phys. Express, 3, 116603 (2010)
- 15) Ishikawa, R., et al., Nature Mater., 10, 278 (2011)
- 16) Shibata, N., et al., J. Electron Microsco., **59**, 473 (2010)
- 17) Shibata, N., et al., Nature Phys., 8, 611 (2012)
- 18) Shibata, N., et al., Sci. Rep., 5, 10040 (2015)
- 19) Pennycook, T.J., *et al.*, *Ultramicroscopy*, **151**, 160 (2015)
- 20) Müller, K., et al., Nature Comm., 5, 5653 (2014)